

SigOFIT 光隔离探头 OIP B 系列（电池供电）

洞见信号的全部真相

基于独家 SigOFIT™ 技术的光隔离探头，拥有极高的共模抑制比和隔离电压，在其带宽范围内洞见信号的全部真相，是判定其他电压探头所测信号真实性的终极裁判。此外，SigOFIT 光隔离探头采用先进的激光供电技术，完美解决了隔离供电的问题。

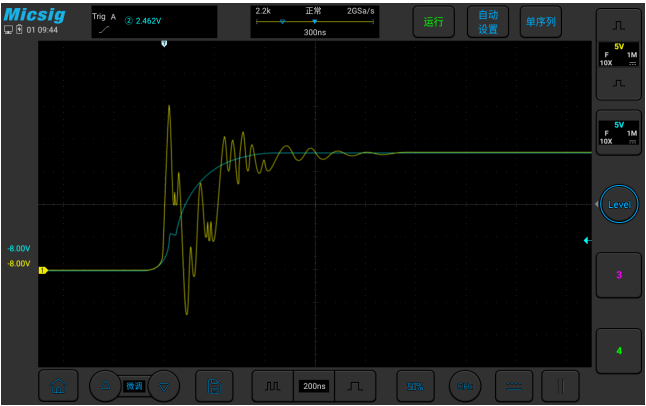
应用领域：

对其他电压探头所测结果准确性、真实性存在质疑时，SigOFIT 光隔离探头可作为最终裁判依据。

- 电源设备评估、电流并联测量、EMI 和 ESD 故障排除
- 电机驱动设计、功率转换器设计、电子镇流器设计
- 氮化镓、碳化硅、IGBT 半 / 全桥设备的设计与分析
- 高压高带宽测试应用的安全隔离测试
- 逆变器、UPS 及开关电源的测试
- 宽电压、宽带测试应用
- 各种浮地测试



产品特点:



■ 差分探头 ■ SigOFIT 光隔离探头

极高的测试精度与稳定性

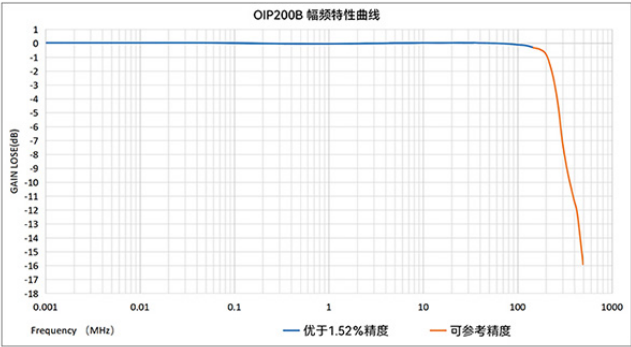
- 作为判定其他电压探头所测信号真实性的终极裁判，测试精度是 SigOFIT 光隔离探头的重要指标。SigOFIT 光隔离探头，具有极佳的幅频特性，直流增益精度优于 1%，底噪小于 1.46mVrms，预热后零点漂移小于 500μV。

最真实的信号呈现

- SigOFIT 光隔离探头具有极高的共模抑制比，在 100MHz 时 CMRR 高达 128dB、在 500MHz 时 CMRR 仍然高达 114dB，是判定其他电压探头所测信号真实性的终极裁判。

第三代半导体的最佳测试手段

- 第三代半导体器件由于导通与关断时间很短，信号具有更快的上升沿和下降沿，信号中具有很高能量的高频谐波，SigOFIT 光隔离探头在最高带宽时，仍然具有超 100dB 的共模抑制比，可以近乎完美地抑制高频共模噪声所产生的震荡，所呈现的信号没有额外多余成分，是第三代半导体测试的不二之选。



测试氮化镓（GaN）不炸管

- SigOFIT 光隔离探头测试引线短且采用同轴传输，探头输入电容低至 2.6pF，测试氮化镓（GaN）十分安全

测试量程更宽

- 不同于高压差分探头只可以测试高压信号，SigOFIT 光隔离探头通过匹配不同的衰减器，可以测试 ±1.25V 至 ±5000V 的差模信号，并实现满量程输出，达到很高的信噪比。

使用灵活

- SigOFIT 光隔离探头比传统高压差分探头体积更小，探头引线更精巧，使用更加灵活方便。

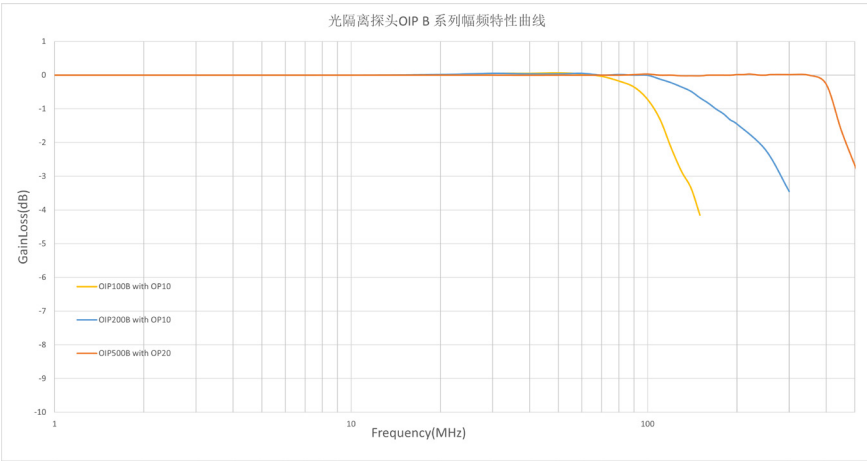
高效便捷

- SigOFIT 光隔离探头响应快，上电即测，校准时间小于 1 秒，可实时保证精确的信号输出。

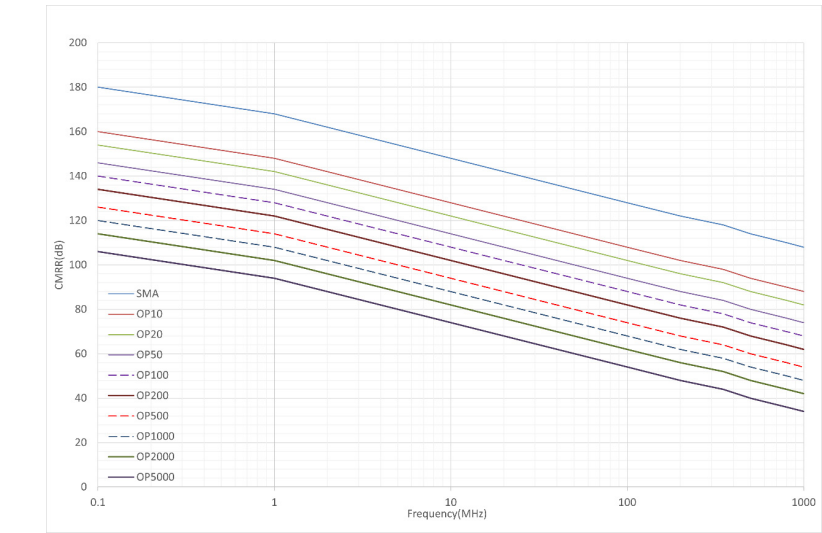


产品参数与图表：

型号	OIP100B	OIP200B	OIP500B
带宽	100MHz	200MHz	500MHz
上升时间	≤3.5ns	≤1.75ns	≤700ps
共模抑制比	DC: 180dB 100MHz: 128dB	DC: 180dB 200MHz: 122dB	DC: 180dB 500MHz: 114dB
差模电压	±5000V		
底噪	<1.46mVrms		
直流增益精度	1%		
共模电压	85kVpk		



幅频特性曲线：不同型号光隔离探头的幅频特性



衰减器 CMRR 曲线：上图展示不同型号衰减器（0dB）在各个频率下的共模抑制能力。